

Изобретение относится к полупроводниковой технике и может быть использовано для детектирования магнитных и электромагнитных полей в современных электронных и оптоэлектронных системах.

Фотоэлектромагнитный датчик включает нанесенный на полуизолирующую полупроводниковую подложку активный полупроводниковый слой типа $no(p\theta)$, на котором нанесены омические контакты питания и контакты для регистрации напряжения Холла. На активном слое $no(p\theta)$ локально нанесен полупроводниковый слой $p+(n+)$, на котором сформирован омический контакт с возможностью освещения слоя $p+(n+)$.

П. формулы: 1

Фиг.: 1